

HTGB and HCI stress induced variability in the nanowire Si MOSFETs

A. BEKADDOUR¹ and Gérard GHIBAUDO²

¹Universite Abou Bekr Belkaid Tlemcen Departement de Physique

²Institut de Microelectronique Electromagnetisme et Photonique Laboratoire
d'Hyperfrequence et Caracterisation

December 31, 2023